



「SiC, GaN パワーデバイスの現状ならびに新しい基板加工技術」

◇ 日時: 2025 年 3 月 7 日(金) 12:30~16:00

◇ 場所: 幕張メッセ 国際会議場 中会議室 201

<https://www.m-messe.co.jp/>

「SiC, GaN 加工技術展 2025」(展示ホール 7・8)の併催行事として開催

<https://sicgan-expo.jp/>

先進パワー半導体デバイス用材料として注目のSiCやGaNは硬くて脆く化学的にも安定な材料であり、基板加工コストの低減はデバイス普及に向けての喫緊の課題の一つである。本研究会ではこれら材料の新しい基板加工技術にフォーカスする。なお、今回新たな取り組みとして「SiC, GaN加工技術展2025」の中での開催とし、SiCならびにGaNパワーデバイスの現状についての講演も設けた。加工に関わる技術者・研究者皆様のSiC, GaNの世界への新規参入の足掛かりとなれば幸いである。

.....プログラム.....

12:30~12:35 開会挨拶

12:35~13:05 SiC パワー半導体の現状と今後の展開

田中 保宣 (産業技術総合研究所)

13:05~13:35 GaN 縦型パワーデバイスの現状と今後の展開

須田 淳 (名古屋大学)

13:35~13:45 休 憩

13:45~14:15 SiC ウェハの高速研磨装置の開発

宮下 忠一 (不二越機械工業株式会社)

14:15~14:45 SiC のワイヤーソー切断技術と新しい平坦化技術

乾 義孝 (株式会社安永)

14:45~14:55 休 憩

14:55~15:25 触媒表面基準エッチング法による SiC および GaN 基板表面の原子レベル平坦化

藤 大雪 (大阪大学)

15:25~15:55 固体電解質を用いた環境調和型電解援用研磨による SiC の高効率平滑化

村田 順二 (立命館大学)

15:55~16:00 閉会挨拶

■参加受付: WEB 参加受付システム ([ここをクリック*](#))から参加登録と参加費のオンライン決済をお願いします。席数に限りがあるため早期に参加受付を終了することがあります。なお、当日の資料は PDF 版となります。

*本案内が印刷物の場合、<http://annex.jsap.or.jp/adps/pdf/kenkyuukai28.pdf> よりアクセスして下さい。

【重要】「SiC, GaN 加工技術展 2025」の参加登録が別途必要となります(参加登録は 2025 年 1 月に開始予定、インターネットからの事前登録無料)。

■参加費: (消費税込)

先進パワー半導体分科会会員* 4,000 円、分科会学生会員 無料、一般 6,000 円、一般学生 1,000 円

*先進パワー半導体分科会賛助会員所属の方は先進パワー半導体分科会会員扱いとします。

■現地開催におけるご協力をお願い: 発熱がある場合は当日のご参加はご遠慮下さい。会場でのマスクの着用は任意とします。

問合せ先:

佐野 泰久 (大阪大学)

e-mail: sano@prec.eng.osaka-u.ac.jp

加藤 智久 (産業技術総合研究所)

e-mail: t-kato@aist.go.jp

白石 陽子 (応用物理学会事務局)

e-mail: shiraishi@jsap.or.jp